

П 63 41

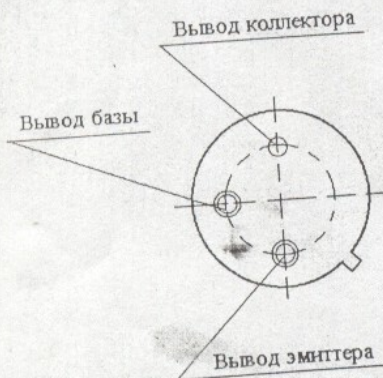
## ЭТИКЕТКА

ЮФЗ.365.043 ЭТ

Кремниевые планарные п-р-п транзисторы типов 2Т630А, Т630Б в металlostеклянном корпусе КТ-2-7 ГОСТ 18472-88, предназначенные для работы в линейных и ключевых схемах. Код даты изготовления транзисторов по ГОСТ 30668-2000.

Заключение ЦОС "Военэлектронсерв"  
ФГУП "22 ЦНИИ Минобороны России"  
№ СВС.01.434.0286.04

## Схема расположения выводов



## 1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Основные электрические параметры при  $t_{\text{окр}} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$ 

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока, ( $U_{\text{кз}} = 10 \text{ В}$ , $I_{\text{к}} = 150 \text{ мА}$ ) 2Т630А 2Т630Б	$h_{21э}$	40 80	120 240
Обратный ток коллектор-эмиттер, ( $U_{\text{кз}} = 90 \text{ В}$ , $R_{\text{бэ}} \leq 3 \text{ кОм}$ ), мкА	$I_{\text{кэр}}$		1
Обратный ток эмиттера, ( $U_{\text{эб}} = 5 \text{ В}$ ), мкА	$I_{\text{эбо}}$		0,1
Граничное напряжение, ( $I_{\text{к}} = 30 \text{ мА}$ , $Q \geq 200$ , $\tau_{\text{н}} \leq 100 \text{ мкс}$ ), В 2Т630А 2Т630Б	$U_{\text{кэо гр}}$	90 80	
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, ( $I_{\text{к}} = 150 \text{ мА}$ , $I_{\text{б}} = 15 \text{ мА}$ ), В	$U_{\text{кэ нас}}$		0,3
Напряжение насыщения база-эмиттер, ( $I_{\text{к}} = 150 \text{ мА}$ , $I_{\text{б}} = 15 \text{ мА}$ ), В	$U_{\text{бэ нас}}$		1,1
Пробивное напряжение коллектор-эмиттер, ( $I_{\text{к}} = 100 \text{ мкА}$ , $R_{\text{бэ}} = 3 \text{ кОм}$ ), В	$U_{\text{кэр проб}}$	120	
Пробивное напряжение эмиттер-база, ( $I_{\text{э}} = 100 \text{ мкА}$ ), В	$U_{\text{эбо проб}}$	7	

1.3 Цветных металлов не содержится.

## 2 НАДЕЖНОСТЬ

2.1 Минимальная наработка транзисторов в режимах и условиях, допускаемых ТУ, 80000 ч, а в облегченных режимах и условиях при мощности 0,5, токах и напряжениях не более 0,7 максимально допустимых значений - 100000 ч при температуре окружающей среды не более 25°C.

2.2 Гамма-процентный ресурс при  $t_{\text{у}} = 95\%$  в режимах и условиях допускаемых ТУ 160000 ч.

2.3. Минимальный срок сохраняемости транзисторов при хранении в отапливаемом хранилище или в хранилище с кондиционированием воздуха, а также транзисторов, смонтированных в защищенную аппаратуру, или в защищенном комплекте ЗИП, 25 лет.

При хранении транзисторов в упаковке предприятия-поставщика в неотапливаемых хранилищах под навесом, а также смонтированных в аппаратуру незащищенных объектов, сроки сохраняемости соответствуют ГОСТ В 22468-77.

## 3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества данных транзисторов требованиям ЮФЗ.365.043 ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, монтажа и эксплуатации, приведенных в этикетке и технических условиях на транзисторы.

Гарантийный срок - 25 лет с даты изготовления.  
Гарантийная наработка:

80000 ч - в режимах и условиях, допускаемых ТУ,  
100000 ч - в облегченном режиме

Гарантийная наработка исчисляется в пределах гарантийного срока.

## 4 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Транзисторы 2Т630А, 2Т630Б соответствуют техническим условиям ЮФЗ.365.043 ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по извещению № 71 от 3.11.04  
дата

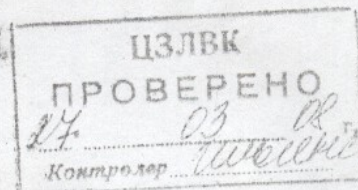
Место для штампа СКК  
Место для штампа ПЗ

Место для штампа "Перепроверка произведена" дата

Приняты по извещению № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ дата

Место для штампа СКК  
Место для штампа ПЗ

Цена договорная



17